## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-328127

(43)公開日 平成4年(1992)11月17日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup> C 0 8 G 73/10 B 4 1 M 5/26	識別記号 NTF	庁内整理番号 9285-4 J	FΙ	技術表示箇所
C 0 9 D 179/08	PLX	8830-4 J		
G 0 2 B 1/04		7132-2K		
		8305 - 2H	B 4 1 M	5/26 Y
			審査請求 未請求	ままでは ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま ままま
(21)出願番号	特願平3-122946		(71)出願人	000004226
				日本電信電話株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)4	月26日		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
			(72)発明者	市野 敏弘
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
				本電信電話株式会社内
			(72)発明者	松浦 徹
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
				本電信電話株式会社内
			(72)発明者	安藤(慎治
				東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日
				本電信電話株式会社内
			(74)代理人	弁理士 中本 宏 (外2名)
				最終頁に続く

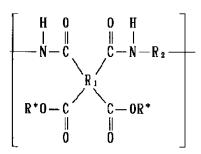
## (54) 【発明の名称】 感光性全フツ素化ポリイミド前駆体及びそれらの製造方法

## (57) 【要約】

【目的】 光電子集積回路を作製するのに十分な耐熱性があり、近赤外域において光透過損失の極めて少ないポリイミドレリーフ構造を提供する。

【構成】 一般式(化1):

【化1】



(式中R\* は感光性の有機基、R1 及びR2 は、ベンゼン環の1~3個からなり、2以上の場合には、R1 では間接に、R2 では直接又は間接に結合しており、この分子中の水素は、すべてフッ素又はパーフルオロアルキル基で置換されている)で表される繰返し単位を含有する感光性全フッ素化ポリイミド前駆体。R\* OHによるエ

ステル化、酸ハライド化、ジアミンとの反応による該前 駆体の製法。 1

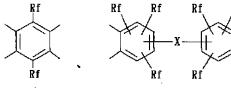
【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(化1):

【化1】

〔ここで式中  $R^*$  は光反応により化学結合を形成し、分子間を橋架けする有機基、 $R_1$  は下記式(化 2):



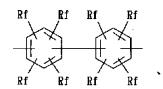


Rf Rf Rf Rf Rf Rf

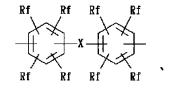
\*で表される基のうちのいずれかの基、R₂ は下記式(化 3):

【化3】





10



Rf Rf Rf Rf Rf Rf Rf

Rf Rf Rf

で表される基のうちのいずれかの基であり、ここで式中 R f はフッ素、又はパーフルオロアルキル基、Xは下記式(化4):

【化4】

K1

20

 $-Rf' - - - (ORf')_{n-1} - - (Rf'O)_{n-1}$ 

- (ORf'O) -- -- -- -- -- -- -- -- --

(ここで式中R f  $^{\prime}$  はパーフルオロアルキレン基、nは  $1\sim10$  の数を示す)で表される基のうちのいずれかの基である〕で表される繰返し単位を含有することを特徴とする感光性全フッ素化ポリイミド前駆体。

【請求項2】 下記一般式(化5):

【化5】

〔式中R1 は一般式(化1)中のR1 と同義である〕で表されるテトラカルボン酸、又はその誘導体と、式R\* OH〔式中R\* は一般式(化1)中のR\* と同義である〕で表される感光性アルコールとを反応させ、その後酸ハライド化し、次いで下記一般式(化6):

【化6】 H2 N-R2 -NH2 〔式中R2 は一般式(化 1)中のR2 と同義である〕で表されるジアミンと反応 させることを特徴とする請求項1に記載の感光性全フッ 素化ポリイミド前駆体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フォトマスクを通して 光照射することにより、照射部が適当な溶媒に不溶化 し、光未照射部をその溶媒によって除去した後、加熱に より硬化させることにより、C-H結合を有しない全フ 少素化ポリイミドのレリーフ構造を形成する感光性全フ ツ素化ポリイミド前駆体に関し、特に光電子集積回路 (OEIC)における光導波路として使用可能な低光損 失率ポリイミドレリーフ構造を形成する感光性全フッ素 化ポリイミド前駆体に関する。

[0002]

【従来の技術】プラスチック材料は、無機系の材料に比べて軽量であり、耐衝撃性、加工性に優れ、取扱いが容易であるなどの優れた特徴を有しているため、これまでも光ファイバーや光ディスク用基板、光学用レンズなど50様々な光学用途に用いられてきた。中でもプラスチック

.3

をOEICにおける光導波路など、近赤外域(波長= 0.  $8 \sim 2$ .  $5 \mu m$ ) での光学材料として用いる場合、 無機系の材料と比較してまず問題となるのは大きな光損 失である。プラスチックにおける損失原因には大きく分 けて光の散乱と光の吸収の2つがあるが、光通信に用い られる波長が今後、長波長域へ移る(0.85μmから 1. 3 μ m ~ 1. 5 μ m ~ ) に従って、後者の原因、つ まり分子構造に本質的な振動吸収による損失が支配的と なり、プラスチック光学材料の光導波特性に大きな制約 をもたらすものと考えられる。特にPMMAやPSのよ 10 うに、分子鎖内に炭素-水素結合(C-H結合)を有す るものは高調波の吸収強度が減衰しにくいこともあっ て、近赤外域での光損失は大きなものとなっている。こ のC-H結合に起因する高調波を小さくしかつ長波長側 ヘシフトさせるためには、分子鎖内の水素を重水素 (D) あるいはフッ素 (F) で置換することが提案され ており、PMMAやPS中の水素を重水素あるいはフッ 素で置換した材料については具体的な検討が既になされ ている〔例えば戒能俊邦、アプライド フィジクス レ ターズ (Appl. Phys. Lett.) 第48巻、第757頁 20 (1986年)参照〕。しかし、これらのプラスチック 光学材料は、例えば基板上でのOEIC作製に必要な耐 熱性(260℃)を持たないため、光電子集積回路等に 適用するには工程上の種々の工夫が必要である。一方、 ポリイミド樹脂はプラスチックの中で最も耐熱性の優れ たものの一つとして知られており、光学材料への適用も 最近検討(IBM、ハネウェル、NTT)され始めてい る。しかしこれまでに検討されたすべてのポリイミドは 分子鎖中にフェニル基のC-H結合を有するため、C-H結合の伸縮振動の高調波あるいはC-H結合の伸縮振 動の高調波と変角振動の結合音が表れ、近赤外域にはな お大きな吸収損失が存在している。これまで全フッ素化 ポリイミドは明らかにされていない。更に、ルブナー ( Rubner ) 等の著書「光反応性重合体前駆物質からの 高耐熱性フィルムパターンの製造」 ( Production of H ighly-Heat Resistant Film Patterns from Photoreact ive Polymer Precursors ) (1976) に記載されてい るように、ポリイミドレリーフ構造を形成する感光性ポ リイミド前駆体が知られているが、形成されたポリイミ ドレリーフ構造がポリイミド分子中にフェニル基のC-H結合を有するため、C-H結合の伸縮振動の高調波あ るいはC-H結合の伸縮振動の高調波と変角振動の結合 音が表れ、近赤外域にはなお大きな吸収損失が存在して いる。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】すなわち近赤外域での OEIC用光学材料として用いるプラスチック材料に は、耐熱性の不足とC-H結合の存在に基づく大きな光 損失という問題があった。本発明はこのような現状にかんがみてなされたものであり、その目的は光電子集積回 50

路を作製するのに十分な耐熱性があり、近赤外域において光透過損失の極めて少ないポリイミドレリーフ構造を 提供することにある。

### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明の第1の発明は感光性全フッ素化ポリイミド前駆体 に関する発明であって、下記一般式(化1):

### 【化1】

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
H & 0 & 0 & H \\
 & || & || & | & | \\
 & N - C & C - N - R_2 \\
\hline
R^* 0 - C & C - 0 R^* \\
 & || & || \\
 & 0 & 0 & 0
\end{array}$$

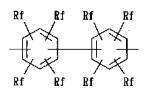
〔ここで式中 $R^*$  は光反応により化学結合を形成し、分子間を橋架けする有機基、 $R_1$  は下記式(化2):

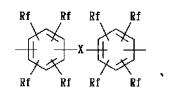
#### 【化2】

で表される基のうちのいずれかの基、 $R_2$  は下記式(化3):

【化3】







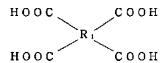
で表される基のうちのいずれかの基であり、ここで式中 \*式(化4): Rfはフッ素、又はパーフルオロアルキル基、Xは下記\* 【化4】

 $-Rf' - (ORf')_{n-1} - (Rf'O)_{n-1}$ 

 $-(ORf'O)_{x}-, -O-CO-Rf'-CO-O-$ 

1~10の数を示す)で表される基のうちのいずれかの 基である〕で表される繰返し単位を含有することを特徴 とする。また、本発明の第2の発明は、上記第1の発明 の感光性全フッ素化ポリイミド前駆体の製造方法に関す る発明であって、下記一般式(化5):

【化5】



〔式中R1 は一般式(化1)中のR1 と同義である〕で 表されるテトラカルボン酸、又はその誘導体と、式R\* OH〔式中R\* は一般式(化1)中のR\* と同義であ る〕で表される感光性アルコールとを反応させ、その後 酸ハライド化し、次いで下記一般式(化6):

【化6】H<sub>2</sub> N-R<sub>2</sub> -NH<sub>2</sub> 〔式中R<sub>2</sub> は一般式(化 1) 中のR2 と同義である〕で表されるジアミンと反応 させることを特徴とする。

【0005】本発明者らは、種々の既存のポリイミド及 びポリイミド光学材料について、その赤外域、近赤外域 30 の吸収スペクトルを測定し、近赤外域での光損失を算出 するとともに、その原因について鋭意検討した。その結 果、近赤外域で大きな光損失を引起こす原因の第1は、 アルキル基やフェニル環等におけるC-H結合の伸縮振 動の高調波吸収、及びC-H結合の伸縮振動の高調波と 変角振動の結合音による吸収であることが明らかとなっ

【0006】本発明の感光性全フッ素化ポリイミド前駆 体は、フォトリソグラフィ工程により形成される全フッ 合するすべての1価元素をフッ素、又はパーフルオロア ルキル基とし、繰返し単位内にC-H結合を持たない構 造とすることによって、近赤外域での最大の光損失原因 であるC-H結合に基づく振動吸収を無くし、またイミ ド結合を主鎖構造に導入してポリイミドとすることによ って、光電子集積回路を作製する上での十分な耐熱性 (260℃以上)を持たせることができる。

【0007】本発明の感光性全フッ素化ポリイミド前駆 体を製造する時に使用するテトラカルボン酸無水物とし ては、分子内のアルキル基、フェニル環等の炭素に結合 50 1, 4-フェニレンジアミン、<math>4, 4'-ジアミノオク

(ここで式中R f'はパーフルオロアルキレン基、n to 10 するすべての1 to 1 to 1 で元素をフッ素、又はパーフルオロアル キル基としたものであればどのようなものでもよい。テ トラカルボン酸無水物前駆体のテトラカルボン酸並びに その誘導体としての酸無水物、酸塩化物、エステル化物 等としては次のようなものが挙げられる:1、4-ジフ ルオロピロメリット酸、1-トリフルオロメチル-4-フルオロピロメリット酸、1,4-ジ(トリフルオロメ チル) ピロメリット酸、1,4-ジ(ペンタフルオロエ チル) ピロメリット酸、ヘキサフルオロー3、31、 4, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸、ヘキサフルオ 20 ロー3, 3´, 4, 4´ーベンゾフェノンテトラカルボ ン酸、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオ ロフェニル) ヘキサフルオロプロパン、1,3-ビス (3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェニル) ヘキサ フルオロプロパン、1,4-ビス(3,4-ジカルボキ シトリフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼン、 ヘキサフルオロー3,3′(又は4,4′)ーオキシビ スフタル酸。酸無水物への転化は、通常の方法で良く、 例えば100℃以上に加熱すればよい。この中でピロメ リット酸二無水物のベンゼン環にフルオロアルキル基を 導入した含フッ素酸二無水物である1、4-ジ(トリフ ルオロメチル)ピロメリット酸二無水物、1,4-ジ (ペンタフルオロエチル) ピロメリット酸二無水物等の 製造方法は特願昭63-165056号明細書に記載さ れている。

6

【0008】上記酸無水物に感光基及び重合反応基とな る酸ハロゲン化基を導入する方法は、通常の方法で良 く、例えば前記ルブナー等の著書に記載されている方法 を使用できる。例えば、次の方式が挙げられる。まず、 2-ヒドロキシエチルメタクリート (HEMA) と酸無 素化ポリイミドがアルキル基、フェニル環等の炭素に結 40 水物を反応させ、感光基を導入する。次に、得られたジ カルボン酸ジエステルが塩化チオニルとの反応によっ て、対応する二酸塩化物に転化される。また本発明に用 いることのできるジアミンの例としては、分子内のアミ ノ基を除くアルキル基、フェニル環等の炭素に結合する すべての1価元素をフッ素、又はパーフルオロアルキル 基としたものであればどのようなものでもよく、3, 4, 5, 6-テトラフルオロー1, 2-フェニレンジア ミン、2, 4, 5, 6-テトラフルオロ-1, 3-フェ ニレンジアミン、2,3,5,6-テトラフルオロー

タフルオロビフェニル、ビス(2,3,5,6-テトラ フルオロー4-アミノフェニル)エーテル、ビス(2, 3, 5, 6-テトラフルオロー4-アミノフェニル)ス ルホン、ヘキサフルオロー2,2'-ビス(トリフルオ ロメチル) -4,4'-ジアミノビフェニル等が挙げら わる.

【0009】感光性全フッ素化ポリイミド前駆体の製造 方法は、通常の感光性全フッ素化ポリイミド前駆体の製 造条件と同じでよく、一般的にはN-メチル-2-ピロ リドン、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメ 10 チルホルムアミドなどの極性有機溶媒中で反応させる。 本発明においてはジアミンまた感光性テトラカルボン酸 二塩化物とも単一化合物で用いるばかりではなく、複数 のジアミン、感光性テトラカルボン酸二塩化物を混合し て用いる場合がある。その場合は、複数又は単一のジア ミンのモル数の合計と複数又は単一の感光性テトラカル ボン酸二塩化物のモル数の合計が等しいかほぼ等しくな るようにする。得られた感光性全フッ素化ポリイミド前 駆体溶液は、水中に注ぎ沈殿させる。更に再沈殿法等に より精製した後、適当な溶媒に溶解してキャスト溶液と 20 する。得られた前述の感光性全フッ素化ポリイミド前駆 体溶液において、その溶液の濃度は5~40重量%(1 0~25重量%であることが好ましい)、また前記ポリ マー溶液の回転粘度(25℃)は、50~5000ポア ズであることが好適である。

【0010】本発明の感光性全フッ素化ポリイミド前駆 体からレリーフ構造を得る方法には、通常の方法が使用 できる。例えば感光性全フッ素化ポリイミド前駆体溶液 を、基板上にスピンコートし、窒素雰囲気下で70~8 0℃で乾燥させて得られる。このフィルムに、フォトマ スクを介して高圧水銀灯等で、紫外線を照射する。適当 な溶媒で未照射部を除去した後、加熱して、残された溶 媒、感光基を除去すると共にイミド化を行い、ポリイミ ドレリーフ構造を得る。加熱は、300℃以上まで段階 的に行うのが一般的である。

## [0011]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に具体的に説 明するが、本発明はこれら実施例に限定されない。

#### 【0012】実施例1

(化7)を持つ1,4-ビス(3,4-ジカルボキシト リフルオロフェノキシ) テトラフルオロベンゼン酸二無 水物:

【化7】

11. 644g (20. 0 mmol) を80gのヘキサメチ ルりん酸トリアミド (HMPTA) に溶解した後、窒素 雰囲気を保ちながら5℃に冷却した。次に、温度が上が らないように注意しながら、HEMA5.204g(4 Ommol) を滴下した後、室温で10日間かくはんした。 温度を-10℃に下げて、塩化チオニル4.759gを 少しずつ加えた。添加終了後、冷却を止めて3時間反応 させた。次に10℃まで温度を下げ、30gのN, N-ジメチルアセトアミド (DMAc) 86gに溶解した以 外の構造式(化8)を持つ2,4,5,6-テトラフル オロー1、3-フェニレンジアミン:

【化8】

を3. 602g (20. 0 mmol) 加えた。この溶液を窒 素雰囲気中、室温で3日間かくはんし、感光性全フッ素 化ポリイミド前駆体のDMAc溶液を得た。この溶液を 水中にあけ、沈殿させた後、再びDMAcに溶かして、 水中に沈殿させる再沈殿精製を2回繰返した。生成物を DMA c に溶かし、20重量%の感光性全フッ素化ポリ イミド前駆体溶液を得た。この溶液に、感光性全フッ素 化ポリイミド前駆体に対して1%のミヒラーケトンを加 え、アルミ板上にスピンコーティングし、窒素雰囲気下 で70℃で2時間乾燥させて、厚さ10μmの感光性フ ィルムを得た。このフィルムに、幅10μmのスリット を持つフォトマスクを介して、365nmの波長域で10 mW/cm²の強度を持つ高圧灯を10秒間照射した後、D MAcで現像し、未照射部を除去した。このフィルムを 160℃で1時間、250℃で30分、350℃で1時 滴下管、窒素導入管を有する容器中で、以下の構造式 40 間加熱したところ、幅10 μm、厚さ5 μmのレリーフ 構造を得た。また、フォトマスクを使わずに感光させ て、5μmの全フッ素化ポリイミドフィルムも作製し た。このポリイミドフィルムの赤外吸収スペクトルを測 定するとイミド基に特有の吸収が、1790cm-1に現 れ、イミド化が完全に進行したことが確認できた。この ポリイミドフィルムの波長0.8~1.7 $\mu$ mの範囲で の光の吸収を測定したところ、図1に示すとおり、水の 吸収以外に光の吸収はなかった。以下に示す比較例1で 作製した従来のポリイミドフィルムに比べて小さかっ 50 た。なお、図1において実線は実施例1の全フッ素化ポ

9

リイミド、破線は後記比較例1のポリイミドにおける、 それぞれ光の吸光度の波長依存性を示すグラフであり、 横軸は波長(μm)、縦軸は吸光度を表す。

### 【0013】実施例2

実施例1と同様に、1, 4 – ビス(3, 4 – ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物と以下の構造式((0)0 で示されるビス((0)2, (0)3, (0)5, (0)6 – テトラフルオロー(0)7 – イーアミノフェニル)エーテル:

## 【化9】

から全フッ素化ポリイミドレリーフ構造とフィルムを得た。このフィルムの吸収スペクトルを測定したところ、 波長  $0.8\sim1.7~\mu\,\mathrm{m}$  の範囲で水の吸収以外に吸収ピークは見られなかった。

## 【0014】実施例3

1, 4-ビス(3, 4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水物と以下の式(化10)の構造を持つビス(2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4-アミノフェニル)スルフィド:

## 【化10】

$$\begin{array}{c|c} F & F & F \\ \hline \\ H_2N & \\ \hline \\ F & F & F \end{array} \begin{array}{c} F & F \\ \hline \\ NH_2 \end{array}$$

から、実施例1と同様の方法で、全フッ素化ポリイミドレリーフ構造とフィルムを得た。このフィルムの吸収スペクトルを測定したところ、波長0.8~1.7μmの範囲で水の吸収以外に吸収ピークは見られなかった。

## 【0015】実施例4

以下の構造式(化11)を持つ1,4-ジフルオロピロメリット酸二無水物:

#### 【化11】

と 2 、 4 、 5 、 6 ーテトラフルオロー 1 、 3 ーフェニレンジアミンから実施例 1 と同様の方法で、全フッ素化ポリイミドレリーフ構造とフィルムを得た。このフィルムの吸収スペクトルを測定したところ、波長 0 . 8 ~ 1 . 7  $\mu$  m の範囲で水の吸収以外に吸収ピークは見られなか 50

った。

#### 【0016】実施例5

1, 4-ジフルオロピロメリット酸二無水物とビス (2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4-アミノフェニル)エーテルから実施例1と同様の方法で全フッ素化レリーフ構造とポリイミドフィルムを得た。このフィルムの吸収スペクトルを測定したところ、波長0.  $8\sim1$ . 7 $\mu$ mの範囲で水の吸収以外に吸収ピークは見られなかった。

10

#### 10 【0017】実施例6

1, 4-ジフルオロピロメリット酸二無水物とビス (2, 3, 5, 6-テトラフルオロ-4-アミノフェニル)スルフィドから、実施例1と同様の方法で全フッ素 化ポリイミド前駆体とフィルムを得た。このフィルムの 吸収スペクトルを測定したところ、波長0.  $8\sim1$ . 7  $\mu$  mの範囲で水の吸収以外に吸収ピークは見られなかった。

#### 【0018】比較例1

以下の構造式(化12)を持つ2,2-ビス(3,4-20 ジカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物:

#### 【化12】

と以下の構造式(化13)で示される2, 2'-ビス (トリフルオロメチル) -4, 4'-ジアミノビフェニル:

## 【化13】

30

40

から、実施例1と同様の方法でポリイミドレリーフ構造とフィルムを得た。このポリイミドフィルムの波長0.  $8\sim1$ .  $7\mu$ mの範囲での光の吸収を測定したところ、図1の破線で示すとおり、1.  $1\mu$ m付近にC-H結合の伸縮振動の3倍音による吸収が、また1.  $4\mu$ m付近にはC-H結合の伸縮振動の高調波と変角振動の結合音による吸収が、また1.  $65\mu$ m付近ではC-H結合の伸縮振動の2倍音による吸収が現れた。

## [0019]

【発明の効果】これらの結果から、本発明の感光性前駆

(7)

特開平4-328127

11

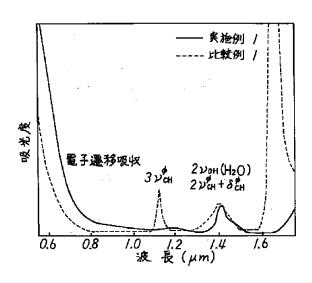
体から得られる全フッ素化ポリイミドは従来のものと比較して、近赤外領域での光透過損失率が極めて小さいことが明らかとなった。

【図面の簡単な説明】

【図1】実線は実施例1の全フッ素化ポリイミド、破線は比較例1のポリイミドにおける、それぞれ光の吸光度の波長依存性を示すグラフである。

12

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 B	6/00	3 9 1	$7036 - 2 \mathrm{K}$		
	6/12	N	7036 - 2K		
G 0 3 F	7/038	5 0 4	7124-2H		

(72)発明者 佐々木 重邦

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日本電信電話株式会社内